

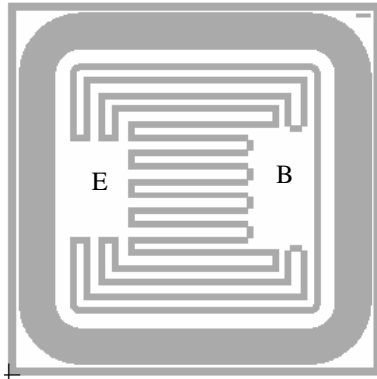
GS118P

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

■ 用 途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

■ 芯片示意图



■ 芯片结构

芯片尺寸	1180 μ m \times 1180 μ m
压焊区尺寸	基 区(B) 160 μ m \times 350 μ m 发射区(E) 205 μ m \times 250 μ m
芯片厚度	220 \pm 10 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
金属层	正面: Al 背面: Ag

■ 电特性(T_a=25 $^{\circ}$ C)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	典型值	单 位
集电极-基极反向电流	I _{CB0}	V _{CB} =630V		1		μ A
发射极-基极反向电流	I _{EB0}	V _{EB} =9V		1		μ A
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _C =0.1mA	650		720	V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =1mA	400		450	V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =0.1mA	9		15	V
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =100mA	10	40		
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =250mA, I _B =50mA		0.5		V
贮存时间	t _S	I _C =0.25A	1.3	3.0		μ s